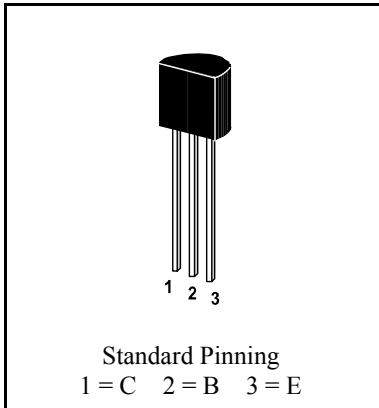


PNP

Si-Epitaxial Planar Transistors

PNP



Power dissipation – Verlustleistung

625 mW

Plastic case

TO-92

Kunststoffgehäuse

(10D3)

Weight approx. – Gewicht ca.

0.18 g

Plastic material has UL classification 94V-0

Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert

Standard packaging taped in ammo pack

Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack

Maximum ratings ($T_A = 25^\circ\text{C}$)**Grenzwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)**

			BC 327	BC 328
Collector-Emitter-voltage	B open	$-V_{CE0}$	45 V	25 V
Collector-Emitter-voltage	B shorted	$-V_{CES}$	50 V	30 V
Emitter-Base-voltage	C open	$-V_{EB0}$	5 V	
Power dissipation – Verlustleistung		P_{tot}	625 mW ¹⁾	
Collector current – Kollektorstrom (DC)		$-I_C$	800 mA	
Peak Coll. current – Kollektor-Spitzenstrom		$-I_{CM}$	1 A	
Base current – Basisstrom		$-I_B$	100 mA	
Junction temp. – Sperrschichttemperatur		T_j	150°C	
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_S	- 65...+ 150°C	

Characteristics, $T_j = 25^\circ\text{C}$ **Kennwerte, $T_j = 25^\circ\text{C}$**

			Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis					
$-V_{CE} = 1\text{ V}, -I_C = 100\text{ mA}$	Group -16	h_{FE}	100	160	250
	Group -25	h_{FE}	160	250	400
	Group -40	h_{FE}	250	400	630
$-V_{CE} = 1\text{ V}, -I_C = 300\text{ mA}$	Group -16	h_{FE}	60	130	–
	Group -25	h_{FE}	100	200	–
	Group -40	h_{FE}	170	320	–

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case

Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 2 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

			Min.	Typ.	Max.
Collector-Emitter cutoff current – Kollektorreststrom					
- V _{CE} = 45 V	BC 327	- I _{CES}	–	2 nA	100 nA
- V _{CE} = 25 V	BC 328	- I _{CES}	–	2 nA	100 nA
- V _{CE} = 45 V, T _j = 125°C	BC 327	- I _{CES}	–	–	10 µA
- V _{CE} = 25 V, T _j = 125°C	BC 328	- I _{CES}	–	–	10 µA
Collector-Emitter breakdown voltage Collector-Emitter Durchbruchspannung					
- I _C = 10 mA	BC 327	- V _{(BR)CES}	20 V	–	–
	BC 328	- V _{(BR)CES}	45 V	–	–
- I _C = 0.1 mA	BC 327	- V _{(BR)CES}	30 V	–	–
	BC 328	- V _{(BR)CES}	50 V	–	–
Emitter-Base breakdown voltage Emitter-Basis-Durchbruchspannung					
- I _E = 0.1 mA		- V _{(BR)EB0}	5 V	–	–
Collector saturation volt. – Kollektor-Sättigungsspannung					
- I _C = 500 mA, - I _B = 50 mA		- V _{CEsat}	–	–	0.7 V
Base-Emitter voltage – Basis-Emitter-Spannung					
- V _{CE} = 1 V, - I _C = 300 mA		- V _{BE}	–	–	1.2 V
Gain-Bandwidth Product – Transittfrequenz					
- V _{CE} = 5 V, - I _C = 10 mA, f = 50 MHz		f _T	–	100 MHz	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität					
- V _{CB} = 10 V, I _E = i _e = 0, f = 1 MHz		C _{CB0}	–	12 pF	–
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R _{thA}	200 K/W ¹⁾	
Recommended complementary NPN transistors Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren			BC 337 / BC 338		

Available current gain groups per type	BC 327-16	BC 327-25	BC327-40
Lieferbare Stromverstärkungsgruppen pro Typ	BC 328-16	BC 328-25	BC328-40

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case

Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 2 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden